

國立成功大學智慧半導體及永續製造學院晶片設計學位學程 論文發表認定原則

112 年 03 月 28 日 111 學年度第二學期第 3 次學程會議通過

112 年 04 月 10 日 111 學年度第 6 次院務會議備查

112 年 06 月 08 日 111 學年度第二學期第 5 次學程會議通過

112 年 06 月 20 日 111 學年度第 7 次院務會議備查

- 一、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院晶片設計博士學位學程（以下簡稱本學程），為辦理本學程博士生發表國際學術論文及發明專利之認定，依本學程修業辦法第六條第二項規定，訂定本原則。
- 二、本學程所稱國際學術論文認定標準如下：
 - （一）須為發表於下列國際期刊或國際頂尖會議之論文：
 1. 國際期刊：IEEE Proc., Journal, Trans., Letters 中與論文有直接關連者，或與 IEEE 相當或更高水準之其他期刊。
 2. 國際頂尖會議論文：具有完整審查制度之國際一流學術會議。
 3. 博士生應至少發表一篇與 IEEE 相當或更高水準之國際期刊或國際頂尖會議論文，且必須參加一次國際會議並以英文口頭報告論文。
 4. 本學程國際學術論文發表認列名單，經本學程會議通過後，公告於本學程網頁。
 - （二）除指導教授外、共同指導教授外，研究生應為論文第一作者，隸屬單位 (affiliation) 應僅列 Program on Integrated Circuit Design, Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing, National Cheng Kung University。但論文發表前，博士生有下列各目情形之一，可增(共)列隸屬單位：
 1. 與本校或本學院簽有正式合作備忘錄或意向書等機構合作，並有支領對方經費者；
 2. 與簽准共同指導教授之單位合作，並有支領對方經費者；
 3. 以在職生身分入學者，可共列其工作單位；
 4. 有支領校內各級單位或中心之經費者。
 - （三）論文通訊作者應為指導教授，且列本校為服務單位(affiliation)之一。
 - （四）論文發表在無明顯標示通訊作者之期刊時，應檢附指導教授為通訊作者之證明。
 - （五）論文須已刊登或已接受刊登。
 - （六）除碩士學位學程逕讀本學程外，論文應為博士班入學後發表。
- 三、本學程所稱發明專利認定標準如下：
 - （一）以修業期間通過美國、日本或歐洲等國之發明專利為原則。
 - （二）專利之發明人應包含博士生及其指導教授。
 - （三）專利之所有權人應包含本校或本學院。
 - （四）專利題目應與其博士學位論文相關。

(五) 專利申請日期應為博士生就讀本校期間。

四、本原則經本學程會議通過後實施，送院務會議備查，修正時亦同。